



汕头华汕电子器件有限公司

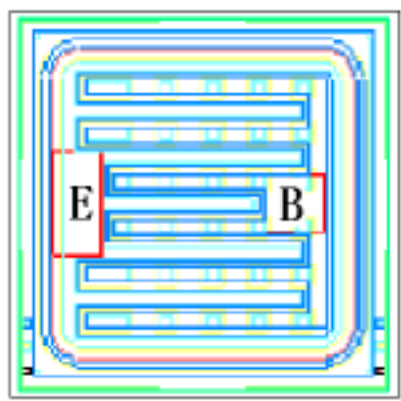
PNP SILICON TRANSISTOR

1020 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：A080BJ-02
芯片厚度： $240 \pm 20 \mu\text{m}$
管芯尺寸： $800 \times 800 \mu\text{m}^2$
焊位尺寸：B 极 $124 \times 124 \mu\text{m}^2$ ；E 极 $221 \times 110 \mu\text{m}^2$
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：2SA1020

管芯示意图



极限值 ($T_a=25$) (TO-92L)

T_{stg} ——贮存温度.....-55~150
 T_j ——结温..... 150
 P_C ——集电极功率耗散 ($T_a=25$)900mW
 V_{CBO} ——集电极—基极电压.....-50V
 V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....-50V
 V_{EBO} ——发射极—基极电压.....-5V
 I_C ——集电极电流.....-2A
 I_B ——基极电流.....-0.5A

电参数 ($T_a=25$) (TO-92L)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-50			V	$I_C=-100\mu\text{A}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-50			V	$I_C=-10\text{mA}$, $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-100\mu\text{A}$, $I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-1	μA	$V_{\text{CB}}=-50\text{V}$, $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-1	μA	$V_{\text{EB}}=-5\text{V}$, $I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	70 40		240		$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$ $V_{\text{CE}}=-2\text{V}$, $I_C=-1.5\text{A}$
$V_{\text{CE}}(\text{sat})$	集电极—发射极饱和电压			-0.5	V	$I_C=-1\text{A}$, $I_B=-50\text{mA}$
$V_{\text{BE}}(\text{sat})$	基极—发射极饱和电压			-1.2	V	$I_C=-1\text{A}$, $I_B=-50\text{mA}$
f_T	特征频率		100		MHz	$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		40		pF	$V_{\text{CB}}=-10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$